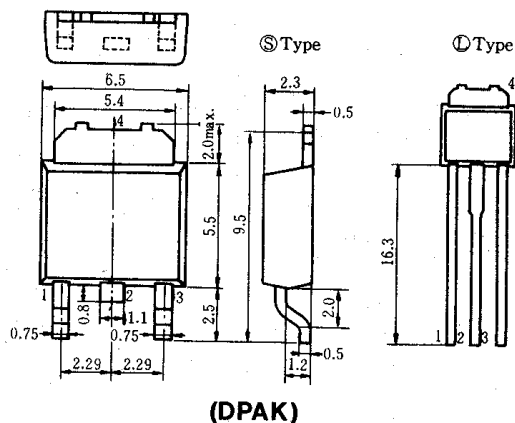


2SK375(L), 2SK375(S)

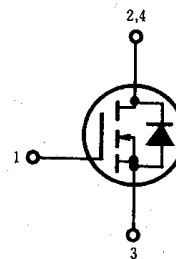
シリコンNチャネルMOS FET
高速度電力スイッチング用

www.DataSheet4U.com

SILICON N-CHANNEL MOS FET
HIGH SPEED POWER SWITCHING



1. ゲート : Gate
2. ドレイン : Drain
3. ソース : Source
4. ドレイン : Drain
(Dimensions in mm)



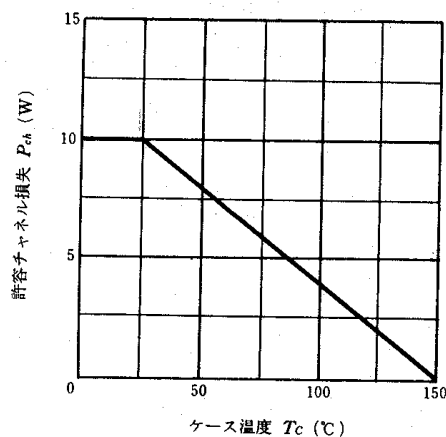
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SK375(L), 2SK375(S)	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}	300	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}	± 20	V
ドレイン電流	I_D	1	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(\text{peak})}$	2	A
逆ドレイン電流	I_{DR}	1	A
許容チャネル損失	P_{ch}^*	10	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容チャネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DS}$	$I_D=10\text{mA}$, $V_{GS}=0$	300	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}$, $V_{DS}=0$	—	—	± 1	μA
ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS}=240\text{V}$, $V_{GS}=0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	$I_D=1\text{mA}$, $V_{DS}=10\text{V}$	1.0	—	5.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D=1\text{A}$, $V_{GS}=15\text{V}^*$	—	2.5	4.0	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(on)}$	$I_D=1\text{A}$, $V_{GS}=15\text{V}^*$	—	2.5	4.0	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=0.5\text{A}$, $V_{DS}=10\text{V}^*$	0.2	0.4	—	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$	—	140	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	65	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}		—	23	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	$I_D=0.5\text{A}$, $V_{GS}=15\text{V}$ $R_L=60\Omega$	—	6	—	ns
立ち上がり時間	t_r		—	14	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	40	—	ns
下降時間	t_f		—	30	—	ns
ダイオード順電圧	V_{DF}	$I_F=1\text{A}$, $V_{GS}=0$	—	0.9	—	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_F=1\text{A}$, $V_{GS}=0$, $di_F/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	—	250	—	ns

* パルス測定

* Pulse Test